

日程表 (会場別 I)

会場名	収容人数	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A201 (201)	214	11:00~11:30 奨励賞贈呈式 11:30~11:40 ExhibitionAward贈呈式	16:15~17:00 代議員会議 17:00~17:15 功労会員表彰式 17:15~17:45 論文賞授賞式 17:45~18:15 フェロー表彰式	9:00~12:15 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30~19:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	9:00~11:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30~17:30 S.18 転位研究の最前線 ~材料を越えた視点から 見えてくるもの~	9:30~11:45 15.1 /0/L結晶成長	13:15~16:15 15.1 /0/L結晶成長
A202 (202)	214		13:15~18:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00~11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30~17:30 S.5 酸化物のテラヘルツ 光物性とデバイス応用へ の展望	9:30~11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15~17:15 6.3 酸化物エレクトロニクス	9:00~12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	
A203 (203)	263	9:00~11:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:15~18:30 S.11 最新動向: 生体材料 と先端デバイスをつなぐ 学際的アプローチ	9:00~11:45 21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物 半導体材料・デバイス」	13:15~18:30 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00~12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15~18:45 12.4 有機EL・トランジスタ	9:00~11:45 S.16 革新デバイスを支 えるIII-V族半導体の成長 技術	13:15~15:15 S.16 革新デバイスを支 えるIII-V族半導体の成長 技術
A204 (204)	263	9:00~12:00 16.3 シリコン系太陽電池	13:30~17:45 S.19 シリコン結晶にお ける不純物制御の科学 ~ ゲッターリングが描く ウェーハの未来像~	9:00~11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:00~19:30 16.3 シリコン系太陽電池	9:00~11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:15~17:00 [コードシェアセッション] 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技 術, 13.5 デバイス/集積 化技術		12:45~17:00 S.21 これからの未来を 担う新ワイドギャップ酸 化物材料Ga2O3
A301 (メインホール)	1000	9:00~12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15~18:45 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00~16:30 S.17 窒化物半導体特異 構造の科学 ~先進GaN 電子デバイスのための結 晶成長・評価・応用~ 16:45~18:30 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15~18:45 15.4 III-V族窒化物結晶	9:00~12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15~16:30 15.4 III-V族窒化物結晶
A401 (401)	53	10:15~11:45 1.1 応用物理一般・学際 領域	13:15~15:15 1.3 新技術・複合新領域 領域・資源・環境	9:00~11:30 1.4 エネルギー変換・貯 蔵・資源・環境	13:45~17:30 1.4 エネルギー変換・貯 蔵・資源・環境	9:00~11:45 2.3 放射線応用・発生装 置・新技術	13:15~15:45 2.1 放射線物理一般・検 出器基礎		
A402 (402+403)	120		13:00~16:00 S.3 フォトニクスにお ける極限計測技術	10:30~12:00 [コードシェアセッション] 3.5 レーザー装置・材 料, 3.14 光制御デバイ ス・光ファイバー	13:15~16:15 3.4 生体・医用光学	9:00~11:45 8.4 プラズマエッチング	13:15~14:45 8.4 プラズマエッチング 15:00~19:30 8.3 プラズマ成膜・表面 処理	9:15~11:45 8.5 プラズマナノテクノ ロジー	13:15~16:15 8.7 プラズマ現象・新応 用・融合分野
A404 (404)	53			9:00~12:00 13.7 ナノ構造・量子現 象・ナノ量子デバイス		9:00~11:45 4.6 Nanocarbon and 2D Materials	13:15~16:15 4.6 Nanocarbon and 2D Materials		
A405 (405+406)	120	9:00~12:15 S.6 材料ナノテクノロ ジー・薄膜とナノ複合体 の表面と界面	13:45~17:30 S.6 材料ナノテクノロ ジー・薄膜とナノ複合体 の表面と界面	9:15~11:45 3.11 フォトニック構 造・現象	13:15~19:30 [コードシェアセッション] 3.11 フォトニック構 造・現象, 13.7 ナノ構 造・量子現象	9:00~11:45 3.12 ナノ領域光科学・近 接場光学	13:15~19:00 3.12 ナノ領域光科学・近 接場光学	9:00~12:15 3.9 テラヘルツ全般	13:30~17:00 3.9 テラヘルツ全般
A409 (409)	102		13:15~16:45 4.2 Bio- and Medical Photonics	9:00~11:45 [Code-sharing session]3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics	14:30~17:15 [Code-sharing session]3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics	9:00~11:45 4.7 Terahertz Photonics	13:15~15:00 4.7 Terahertz Photonics 15:15~16:45 [Code-sharing session]3.9 Terahertz technologies, 4.7 Terahertz Photonics	9:00~12:45 4.3 Nano- and Micro- Photonics	
A410 (410)	108	9:00~11:45 4.1 Plasmonics	13:15~17:45 4.1 Plasmonics	9:00~11:45 4.1 Plasmonics	13:15~18:15 4.4 Opto-electronics	9:00~11:45 3.11 フォトニック構 造・現象	13:15~16:45 4.9 Quantum Optics	9:30~11:45 3.7 レーザープロセス ング	13:15~17:00 4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering
A411 (411)	102	9:00~11:30 チュートリアル 早瀬修二	13:15~16:45 15.2 II-VI族結晶および 多元系結晶	9:00~11:30 チュートリアル 山下一郎	13:15~17:15 S.4 ハイブリッド量子系 における電磁界制御	9:00~11:30 チュートリアル 酒井朗	13:15~18:00 1.5 計測技術・計測標準 ン	9:00~11:45 13.1 Si系基礎物性・表面 界面・シミュレーション	13:15~16:00 13.1 Si系基礎物性・表面 界面・シミュレーション
A412 (412)	108	9:00~11:30 チュートリアル 内藤紀彦	13:30~16:00 チュートリアル 内藤方夫	9:00~11:45 6.2 カーボン系薄膜	13:15~17:30 6.2 カーボン系薄膜	9:30~11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:30~16:45 6.2 カーボン系薄膜		13:00~16:15 9.3 ナノエレクトロニクス
A413 (413)	102	9:15~11:45 8.2 プラズマ診断・計測	13:15~17:00 3.3 情報フォトニクス・ 画像工学 17:15~18:30 [Code-sharing session]3.3 Information photonics and image engineering, 4.5 Information Photonics	9:00~11:45 12.1 作製・構造制御	13:15~18:00 12.1 作製・構造制御	9:00~11:30 8.1 プラズマ生成・制御	16:00~18:30 8.1 プラズマ生成・制御	9:00~10:45 10.3 スピンデバイス・ 磁気メモリ・ストレージ 技術 10:45~12:00 10.4 半導体スピントロ ニクス・超伝導・強相関	13:00~14:45 10.4 半導体スピントロ ニクス・超伝導・強相関
A414 (414)	108	9:15~11:45 3.8 光計測技術・機器	13:15~17:15 3.10 光量子物理・技術	9:00~11:45 3.8 光計測技術・機器	13:15~19:00 3.8 光計測技術・機器	9:45~11:45 13.9 光物性・発光デバ イス	13:15~17:45 13.9 光物性・発光デバ イス	9:30~11:30 13.9 光物性・発光デバ イス	13:15~15:15 13.9 光物性・発光デバ イス
A501 (501)	410		13:00~17:10 [特別シンポジウム]IoT がもたらす近未来サー ビスと最先端デバイス技術	9:00~12:15 12.5 有機太陽電池	13:30~19:30 12.5 有機太陽電池	9:00~12:00 12.5 有機太陽電池	13:00~17:45 [特別シンポジウム]物質 中のトポロジ: 応用に どのように結びつくと か?	9:00~11:45 12.5 有機太陽電池	
A502 (502)	100	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオ チップ	13:45~17:15 9.5 新機能材料・新物 性	9:00~12:45 9.1 誘電材料・誘電体	13:45~15:45 12.7 医用工学・バイオ チップ	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオ チップ	13:45~17:05 S.10 萌芽的デバイスと しての有機センサー - IoT時代に向けて-	9:00~12:15 12.7 医用工学・バイオ チップ	
A503 (503)	100	10:45~12:00 9.4 熱電変換	13:45~18:00 9.4 熱電変換	9:00~12:30 15.7 結晶評価, 不純 物・結晶欠陥	13:45~17:00 15.7 結晶評価, 不純 物・結晶欠陥	9:00~12:15 12.6 ナノバイオテクノ ロジー	13:45~18:45 12.6 ナノバイオテクノ ロジー	9:00~12:00 12.6 ナノバイオテクノ ロジー	
A504 (504+505)	100	9:15~12:15 12.2 評価・基礎物性	13:45~18:15 12.2 評価・基礎物性	9:30~12:00 12.2 評価・基礎物性	13:15~15:30 12.2 評価・基礎物性	9:00~12:15 [コードシェアセッション] 3.13 半導体光デバイ ス, 3.15 シリコンフォ トニクス	13:45~17:45 12.5 有機太陽電池	9:00~12:30 6.1 強誘電体薄膜	13:30~17:00 6.1 強誘電体薄膜

日程表 (会場別Ⅱ)

会場名	収容人数	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S21 (パレスA)	180	9:30~12:30 S.23 多元系化合物・太陽電池のこれまでとこれから - 多元系化合物・太陽電池研究会 30周年記念シンポジウム-	14:00~17:15 S.23 多元系化合物・太陽電池のこれまでとこれから - 多元系化合物・太陽電池研究会 30周年記念シンポジウム-	9:30~11:45 13.10 化合物太陽電池	13:30~17:30 S.2 国際リニアコライダー計画とその技術	9:30~11:15 13.10 化合物太陽電池	13:00~18:45 13.10 化合物太陽電池	9:00~12:00 【コードシェアセッション】3.11 フォトニック構造・現象, 3.12 ナノ領域光学・近接場光学	13:15~17:00 3.12 ナノ領域光学・近接場光学
S22 (パレスB)	228	9:45~11:45 8.6 プラズマライファイエンス	13:00~14:30 8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 14:30~15:00 8.8 Plasma Electronics English Session 15:15~18:00 8.6 プラズマライファイエンス	9:45~10:45 8.10 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 11:00~11:30 8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30~17:20 S.8 先進農業に向けたプラズマ応用最前線 ~新たな植物生育環境の開発・制御~	9:00~12:00 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:30~17:15 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	9:00~11:30 3.1 光学基礎・光学新領域 電子デバイス・プロセス技術	
S41 (第1会議室)	55	10:45~11:45 16.2 エナジーハーベスティング	13:15~18:45 7.2 電子ビーム応用	9:00~12:15 【コードシェアセッション】7.1 X線技術, 7.4 量子ビーム界面構造計測	13:30~16:15 7.5 イオンビーム一般		13:15~17:15 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用		
S42 (第2会議室)	55		13:15~17:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術		13:15~18:00 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	9:00~12:00 11.1 基礎物性	13:15~17:45 11.1 基礎物性		
S43 (第3会議室)	65	9:30~11:45 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:15~16:45 2.2 検出器開発	9:30~11:45 2.2 検出器開発	13:15~19:15 11.4 アナログ応用および関連技術	9:00~12:15 11.4 アナログ応用および関連技術	13:30~18:15 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
S44 (第5会議室)	65	9:00~12:00 【コードシェアセッション】7.1 X線技術, 7.4 量子ビーム界面構造計測	13:30~16:15 【コードシェアセッション】7.1 X線技術, 7.4 量子ビーム界面構造計測	9:15~11:45 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	13:15~19:00 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	9:30~11:45 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	13:15~18:15 3.1 光学基礎・光学新領域	9:00~11:45 3.1 光学基礎・光学新領域	
S45 (第6会議室)	65		13:30~18:00 3.6 超高速・高強度レーザー	9:30~11:30 3.6 超高速・高強度レーザー	13:00~19:00 3.6 超高速・高強度レーザー	9:00~11:15 3.7 レーザープロセスング	13:15~17:30 3.7 レーザープロセスング		
C11 (事務室1)	100	9:00~12:00 13.3 絶縁膜技術	13:45~16:30 13.3 絶縁膜技術	9:00~12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:45~17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00~12:15 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	13:45~19:30 17.3 層状物質	9:00~12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	
C13 (事務室2-2)	80		13:45~18:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	9:00~12:15 3.15 シリコンフォトニクス	13:45~18:15 3.15 シリコンフォトニクス	9:00~12:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45~18:00 S.14 GFIS (電界電離カソードイオン源)・先端イオン源顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開発への応用		
C14 (事務室3-1)	80	10:00~12:00 3.5 レーザー装置・材料	13:45~17:30 3.5 レーザー装置・材料	9:00~12:45 3.13 半導体光デバイス	13:45~18:45 3.13 半導体光デバイス	9:00~11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:45~16:00 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	9:00~12:15 6.5 表面物理・真空	13:30~15:15 6.5 表面物理・真空
C16 (研修室1)	200		13:15~16:45 S.15 新物質/量子構造に基づく発光デバイス研究の最前線と展望	9:45~12:15 17.3 層状物質	13:45~19:15 S.20 機能性原子膜材料の最新応用研究と将来展望	9:00~12:15 17.2 グラフェン	13:45~19:00 17.2 グラフェン	9:00~13:30 17.2 グラフェン	
C17 (研修室2)	200	9:30~12:15 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45~18:15 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	9:00~11:30 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:45~17:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	9:00~12:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:45~18:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	9:00~12:15 3.2 材料・機器光学	
C18 (C18)	140	9:00~12:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:00~14:45 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術) 14:45~19:00 【コードシェアセッション】10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術, 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	9:00~12:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:15~17:00 S.9 光とスピンの織りなす研究の最前線	9:00~11:15 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30~18:30 S.13 I-V族系半導体の製膜と低温結晶化 (固相結晶化を中心に)	9:00~12:15 13.5 デバイス/集積化技術	13:45~16:00 13.5 デバイス/集積化技術
C19 (C19)	140		13:15~17:15 S.22 フレキシブル環境発電デバイスの新展開	9:45~12:15 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	13:45~17:30 S.7 新デバイス・材料開発のためのナノスケール3次元分析 (1)	9:15~12:00 【コードシェアセッション】6.5 表面物理・真空, 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	13:45~17:25 S.12 マルチスケールプロセスへの挑戦~ドライカワエツトかそれとも...	9:30~11:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:15~15:00 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶
C21 (C21)	104	9:00~11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:45~17:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	9:15~12:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:45~19:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	9:00~12:30 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術		9:15~12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	
C22 (C22)	104		13:15~15:30 1.6 超音波	9:15~12:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:45~17:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	9:00~12:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」			
C23 (C23)	104				13:45~18:15 6.4 薄膜新材料	9:00~11:45 6.4 薄膜新材料	13:45~19:30 6.4 薄膜新材料		
C24 (C24)	104	9:00~11:30 10.5 磁場応用	14:30~17:00 S.1 科学技術の人材育成および教育の取組みとその活性化 -九州地区-	9:30~11:45 6.6 ブローブ顕微鏡	13:45~17:15 6.6 ブローブ顕微鏡	9:30~12:00 6.6 ブローブ顕微鏡	13:45~19:00 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	9:00~12:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	

日程表 (会場別Ⅲ)

会場名	収容人数	2017年9月5日(火)		2017年9月6日(水)		2017年9月7日(木)		2017年9月8日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
PA1 ~ PA15 (1階)	ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン		[13:30~15:30] 17 ナノカーボン	[09:30~11:30] 1.2 教育 3.4 生体・医用光学 3.9 テラヘルツ全般 3.10 光量子物理・技術 7.1 X線技術 7.2 電子ビーム応用 7.3 微細パターン・微細構造形成技術 7.5 イオンビーム一般 13.3 絶縁膜技術	[13:30~15:30] 3.5 レーザー装置・材料 3.7 レーザープロセスング 3.12 ナノ領域光学・近接場光学 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 13.10 化合物太陽電池 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 16:00~18:00 13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 13.9 光物性・発光デバイス	[09:30~11:30] 1.5 計測技術・計測標準 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 材料・機器光学 3.6 超高速・高強度レーザー 3.8 光計測技術・機器 6.1 強誘電体薄膜	[13:30~15:30] 3.11 フォトニック構造・現象 3.15 シリコンフォトニクス 8.1 プラズマ生成・制御 8.5 プラズマナノテクノロジー 8.6 プラズマライファイエンス 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 [16:00~18:00] 2 放射線 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶 22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[09:30~11:30] 6.2 カーボン系薄膜 6.4 薄膜新材料 12.4 有機EL・トランジスタ 21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	[13:30~15:30] 6.3 酸化物エレクトロニクス 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術
PB1 ~ PB8 (2階)	ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン		[13:30~15:30] 3.13 半導体光デバイス 16.2 エナジーハーベスティング 16.3 シリコン系太陽電池 [16:00~18:00] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 1.6 超音波 15.6 IV族系化合物(SiC)	[09:30~11:30] 11 超伝導	[13:30~15:30] 9.1 誘電材料・誘電体 9.4 熱電変換 9.5 新機能材料・新物性 [16:00~18:00] 12.2 評価・基礎物性 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ	[09:30~11:30] 9.3 ナノエレクトロニクス 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 13.5 デバイス/集積化技術	[13:30~15:30] 6.5 表面物理・真空 6.6 フローブ顕微鏡 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.7 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 [16:00~18:00] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[09:30~11:30] 3.3 情報フォトニクス・画像工学 4 JSAP-OSA Joint Symposia 2017 8.2 プラズマ診断・計測 8.3 プラズマ成膜・表面処理 8.8 Plasma Electronics English Session	[13:30~15:30] 15.4 III-V族窒化物結晶



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください
気になる講演をブックマークできたり、講演ごとにメモを入れることができたり、
便利な機能も満載です！

講演会アプリ



iTunes(App Store)

8月中旬リリース予定

講演会アプリ



Google Play

8月中旬リリース予定

webプログラム



本部行事(表彰式、代議員会議)

授賞式一覧	日にち: 2017年9月5日(火)	会場: A201
第42回講演奨励賞 贈呈式		11:00~11:30
Exhibition Award 贈呈式		11:30~11:40
代議員会議		16:15~17:00
功労会員 表彰式		17:00~17:15
第39回論文賞 授賞式		17:15~17:45
第11回フェロー 表彰式		17:45~18:15